

請求の範囲

- [請求項1] 基材層と、前記基材層の第1面側に設けられ、かつ、電子部品を仮固定するための粘着性樹脂層（A）と、前記基材層の第2面側に設けられた粘着性樹脂層（B）と、前記基材層と前記粘着性樹脂層（A）との間または前記基材層と前記粘着性樹脂層（B）との間に設けられ、かつ、外部刺激により架橋可能な凹凸吸収性樹脂層（C）と、を備える粘着性フィルムと、
- 前記粘着性フィルムの前記粘着性樹脂層（A）に貼り付けられ、かつ、凹凸構造を有する電子部品と、を備える構造体を準備する準備工程と、
- 前記構造体中の前記凹凸吸収性樹脂層（C）に対して外部刺激を与えることにより、前記凹凸吸収性樹脂層（C）を架橋する架橋工程と、
- 封止材により前記電子部品を封止する封止工程と、
- を少なくとも備える電子装置の製造方法。
- [請求項2] 請求項1に記載の電子装置の製造方法において、
- 前記粘着性樹脂層（B）が外部刺激により粘着力が低下する層である電子装置の製造方法。
- [請求項3] 請求項1または2に記載の電子装置の製造方法において、
- 前記外部刺激が熱または光である電子装置の製造方法。
- [請求項4] 請求項1乃至3のいずれか一項に記載の電子装置の製造方法において、
- 前記凹凸吸収性樹脂層（C）が少なくとも前記基材層と前記粘着性樹脂層（A）との間に設けられている電子装置の製造方法。
- [請求項5] 請求項1乃至4のいずれか一項に記載の電子装置の製造方法において、
- 前記電子部品の前記凹凸構造はバンプ電極を含む電子装置の製造方法。

- [請求項6] 請求項5に記載の電子装置の製造方法において、
前記バンプ電極の高さを H [μm]とし、前記凹凸吸収性樹脂層の厚みを d [μm]としたとき、 H/d が 0.01 以上 1 以下である電子装置の製造方法。
- [請求項7] 請求項1乃至6のいずれか一項に記載の電子装置の製造方法において、
前記凹凸吸収性樹脂層(C)を架橋して得られる凹凸吸収性樹脂層(C')の 125°C における貯蔵弾性率 E' が $1.0 \times 10^6 \text{ Pa}$ 以上 $1.0 \times 10^9 \text{ Pa}$ 以下である電子装置の製造方法。
- [請求項8] 請求項1乃至7のいずれか一項に記載の電子装置の製造方法において、
前記凹凸吸収性樹脂層が架橋性樹脂を含む電子装置の製造方法。
- [請求項9] 請求項1乃至8のいずれか一項に記載の電子装置の製造方法において、
前記凹凸吸収性樹脂層の厚みが $10 \mu\text{m}$ 以上 $1000 \mu\text{m}$ 以下である電子装置の製造方法。
- [請求項10] 請求項1乃至9のいずれか一項に記載の電子装置の製造方法において、
前記構造体が前記粘着性樹脂層(B)に貼り付けられた支持基板をさらに備える電子装置の製造方法。
- [請求項11] 請求項10に記載の電子装置の製造方法において、
前記封止工程の後に、外部刺激を与えることにより前記粘着性樹脂層(B)の粘着力を低下させて前記構造体から前記支持基板を剥離する第1剥離工程をさらに備える電子装置の製造方法。
- [請求項12] 請求項11に記載の電子装置の製造方法において、
前記第1剥離工程の後に、前記電子部品から前記粘着性フィルムを剥離する第2剥離工程をさらに備える電子装置の製造方法。
- [請求項13] 請求項1乃至12のいずれか一項に記載の電子装置の製造方法にお

いて、

前記封止材がエポキシ樹脂系封止材である電子装置の製造方法。

[請求項14] 請求項1乃至13のいずれか一項に記載の電子装置の製造方法において、

前記粘着性樹脂層(A)を構成する粘着性樹脂が(メタ)アクリル系粘着性樹脂、シリコン系粘着性樹脂、ウレタン系粘着性樹脂、オレフィン系粘着性樹脂およびスチレン系粘着性樹脂から選択される一種または二種以上を含む電子装置の製造方法。

[請求項15] 基材層と、前記基材層の第1面側に設けられ、かつ、電子部品を仮固定するための粘着性樹脂層(A)と、前記基材層と前記粘着性樹脂層(A)との間に設けられ、かつ、外部刺激により架橋可能な凹凸吸収性樹脂層(C)と、を備える粘着性フィルムと、

前記粘着性フィルムの前記粘着性樹脂層(A)に貼り付けられ、かつ、凹凸構造を有する電子部品と、を備える構造体を準備する準備工程と、

前記構造体中の前記凹凸吸収性樹脂層(C)に対して外部刺激を与えることにより、前記凹凸吸収性樹脂層(C)を架橋する架橋工程と、

封止材により前記電子部品を封止する封止工程と、
を少なくとも備える電子装置の製造方法。